

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公表番号】特表2008-524406(P2008-524406A)

【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2007-547244(P2007-547244)

【国際特許分類】

C 08 G 64/24 (2006.01)

【F I】

C 08 G 64/24

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月3日(2008.12.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

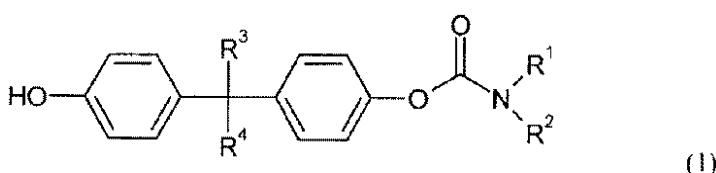
【請求項1】

ホスゲン化工程における温度が0～40であり、かつ触媒添加時における反応混合物の温度が10～40であり、触媒が溶液中に存在し、かつビスフェノールのモル対ホスゲンのモルの比が1：1.05～1：1.20であることを特徴とする、ポリカーボネートの製造方法。

【請求項2】

カーボネート構造の加水分解後に測定される式(1)

【化1】



(式中、

R¹およびR²は互いに独立して水素またはC₁～C₁₂-アルキルであるかまたは

R¹およびR²は全体としてC₄～C₁₂-アルキリデンであり、

R³およびR⁴は互いに独立して水素またはC₁～C₁₂-アルキルであるかまたはR³およびR⁴はそれらが結合している炭素原子と共にシクロヘキシルまたはトリメチルシクロヘキシルを形成する。)

の化合物の含量が0.25 ppm～180 ppmである、請求項1記載のポリカーボネートの製造方法。

【請求項3】

触媒添加時における反応混合物の温度が5～36であることを特徴とする、請求項1記載の方法。